

Low Frequency Transistor

低頻三極管

FHC4672

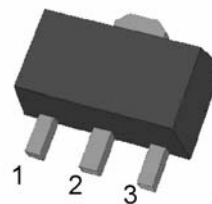
DESCRIPTION & FEATURES 概述及特點

1) Low saturation voltage

$$V_{CE(sat)} = 0.1V(\text{Typ}) \text{ at } I_C/I_B = 1A/50mA$$

2) Excellent DC current gain characteristics

SOT-89



PIN ASSIGNMENT 引腳說明

PIN NAME 管腳符號	PIN NUMBER 引腳序號	FUNCTION 功能
	SOT-89	
B	1	BASE
C	2	COLLECTOR
E	3	EMITTER

MAXIMUM RATINGS($T_a=25^\circ\text{C}$) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	50	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	60	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	6	Vdc
Collector Current(DC) 集電極電流-直流	I_C	2	Adc
Collector Current(Pulse) 集電極電流-脈衝	I_{CP}	5	Adc

THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_c	500	mW
Junction and Storage Temperature 結溫 and 儲存溫度	T_J T_{stg}	150 , -55 ~ 150	$^\circ\text{C}$

DEVICE MARKING 打標

FHC4672P=DKP(80~180) , FHC4672Q=DKQ(120~270)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明, 溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0mA$	50	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=50\mu A$	60	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=50\mu A$	6	—	—	V
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=60V$	—	—	100	nA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V$	—	—	100	nA
DC Current Gain 直流電流增益	h_{FE}	$V_{CE}=2.0V, I_C=0.5A$	82	—	270	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=1A, I_B=50mA$	—	0.1	0.35	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=2V, I_E=0.5A, f=100MHz$	—	210	—	MHz
Collect Output Capacitance 輸出電容	C_{Ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz$	—	25	—	pF